

2SD795

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波電力増幅用および低速度スイッチング用

NPN Silicon Epitaxial Transistor
Audio Frequency Power Amplifier
Low Speed Switching

特長

- DDモードドライブ用に最適である。
- $V_{CE(sat)}$ が小さい $\rightarrow V_{CE(sat)} \left(\frac{2A}{0.2A} \right) \leq 0.7V$
- h_{FE} リニアリティが良く、 h_{FE} も高い $\rightarrow h_{FE} \left(\frac{1V}{2.5A} \right) \geq 30$

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

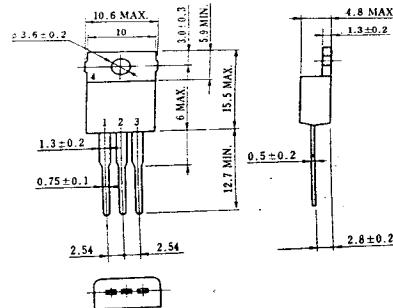
項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	40	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	3.0	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	6.0	A
ベース電流(直流)	$I_{B(DC)}$	0.6	A
全損失	$P_{T(T_c=25^\circ C)}$	20	W
全損失	$P_{T(T_a=25^\circ C)}$	1.5	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ C$

* $PW \leq 10ms$, duty cycle $\leq 50\%$

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 50V, I_E = 0$			1.0	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 3.0V, I_C = 0$			1.0	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = 1.0V, I_C = 0.5A^*$	60	160	400	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = 1.0V, I_C = 2.5A^*$	30			
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2A, I_B = 0.2A^*$		0.3	0.7	V
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 1.0V, I_C = 0.5A^*$		0.75	0.9	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = 5.0V, I_C = 0.1A$		95		MHz
コレクタ容量	C_{cb}	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1.0MHz$		40		pF

* パルス測定 $PW \leq 350\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$ / Pulse Test
 h_{FE} 区分 (h_{FE1}) / R: 60-120 Q: 100-200 P: 160-320 E: 200-400

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS
(Unit: mm)

電極接続

1. Base EIAJ : SC-46
2. Collector (Fin) JEDEC : TO-220AB
3. Emitter IEC : -
4. Fin